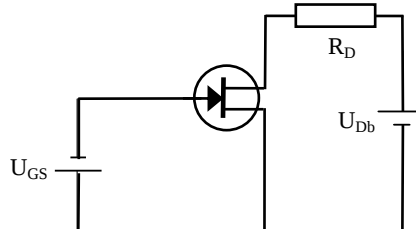


ZADACI IZ ELEKTRONIKE

FET TRANZISTORI

1. N-kanalni FET s uzemljenim izvorom ima radnu točku $V_{DS} = 6\text{ V}$, $I_D = 6\text{ mA}$, $R_D = 0.5\text{ k}\Omega$.
- Ako se I_D poveća na 10 mA , koliki je novi V_{GS} ?
 - Pri tako određenom V_{GS} i $I_D = 6\text{ mA}$, koliki treba biti napon baterije?



Rj: $V_{GS} = -0.9\text{ V}$; $V_{Db} = -4.3\text{ V}$

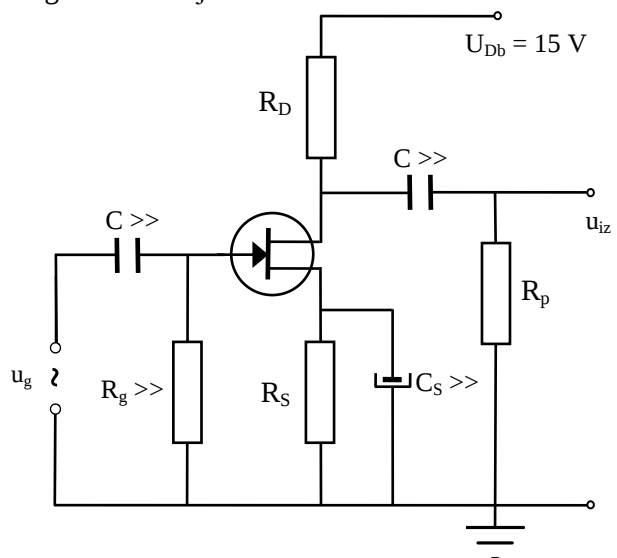
2. Odredi grafički pomoću priloženih strujno-naponskih karakteristika radnu točku i pripadnu strminu (transkonduktanciju g_0) u sklopu prema shemi. Odredi pojačanje sklopa. Spojni FET dobiven je epitaksijalnim rastom silicija s koncentracijom primjesa $N_D = 2.5 \cdot 10^{15}\text{ cm}^{-3}$ (vodljivost elektrona iznosi $\mu_n = 1150\text{ cm}^2/\text{Vs}$) debljine $7\text{ }\mu\text{m}$ na podlozi jako dopiranog monokristala p-tipa ($N_A \approx 10^{19}\text{ cm}^{-3}$). U epitaksijalni sloj udifundiran je planarnom tehnologijom p-tip ($N_A \approx 10^{19}\text{ cm}^{-3}$) do dubine $4.5\text{ }\mu\text{m}$ i tako stvoren n-kanal između izvora S i odvoda D tranzistora s omjerom širine prema dužini $Z/L = 170$. Odredi analitički vodljivost i otpor kanala u linearnom području karakteristika za napon vratiju V_G (u kratkom spoju s podlogom) koji odgovara radnoj točki.

$$\epsilon_S = \epsilon' \epsilon_0 = 11.7 \cdot 8.859 \cdot 10^{-14}\text{ F/cm}$$

$$R_p = 1\text{ k}\Omega$$

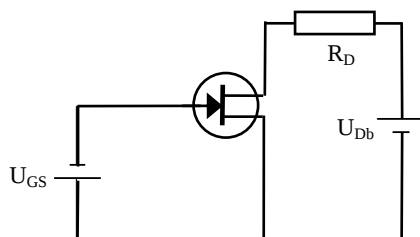
$$R_D = 0.9\text{ k}\Omega$$

$$R_S = 0.1\text{ k}\Omega$$



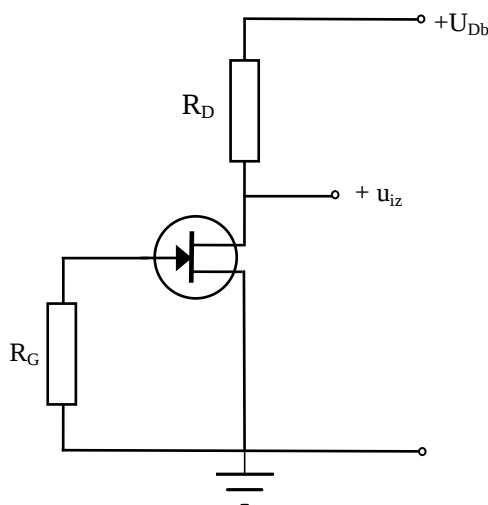
Rj: $V_D = 5\text{ V}$, $I_D = 10\text{ mA}$, $V_G = -1\text{ V}$; $g_m = 4.6\text{ mA/V}$;
 $g = 4.3 \cdot 10^{-3}\text{ }\Omega^{-1}$, $R = 232\text{ }\Omega$; $A_v = -2.18$

3. Spojni n-kanalni FET sa zajedničkim uvodom koristi se kao pojačalo signala. Odredite položaj radne točke ako je struja $I_{DS} = 9 \text{ mA}$, napon $U_{DS} = 3 \text{ V}$, a otpor na odvodu $R_D = 440 \Omega$. Ako se na ulazu nalazi promjenjivi signal amplitude 1 V , grafički odredite pojačanje i amplitudu izlaznog signala. Ako se I_{DS} smanji na 6 mA , odredite koordinate radne točke (U_{GS} i U_{DS}). Na tako određenom novom U_{GS} i sa strujom $I_{DS} = 4 \text{ mA}$ odredite napon napajanja U_{Db} .



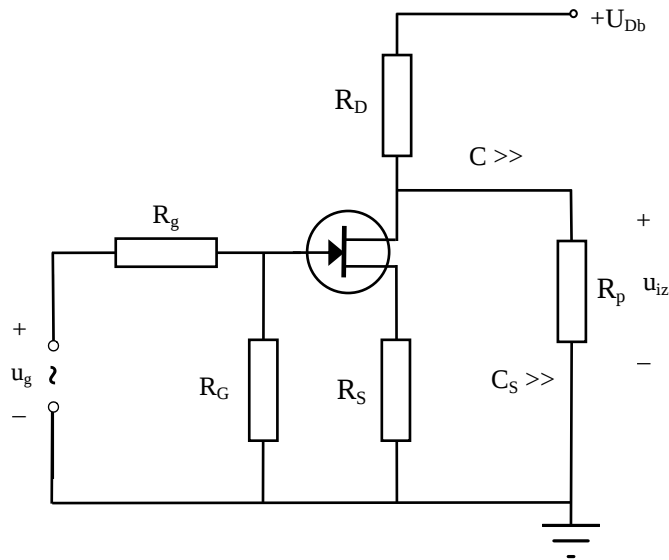
Rj. Q_2 ($I_{DS}=6 \text{ mA}$, $U_{DS}=4.4 \text{ V}$, $U_{GS}=-2 \text{ V}$), Q_3 ($I_{DS}=4 \text{ mA}$, $U_{DS}=1.55 \text{ V}$, $U_{GS}=-2 \text{ V}$), $U_{Db}=3.3 \text{ V}$, $A_v=1.15$

4. Linearno pojačalo s FET-om ima slijedeće karakteristike: $\mu = 20$, $S = 2.6 \text{ mA/V}$, dok je na odvod spojen otpornik $R_D = 2 \text{ k}\Omega$. Ulazni napon iznosi $f = 800 \text{ Hz}$. Odredite:
- Naponsko pojačanje
 - Naponsko pojačanje ako se na izvor (uvod) spoji otpornik R_S
 - Koju vrijednost kondenzatora C_S treba koristiti da se zanemari utjecaj otpora R_S na pojačanje za $R_S = 1 \text{ k}\Omega$



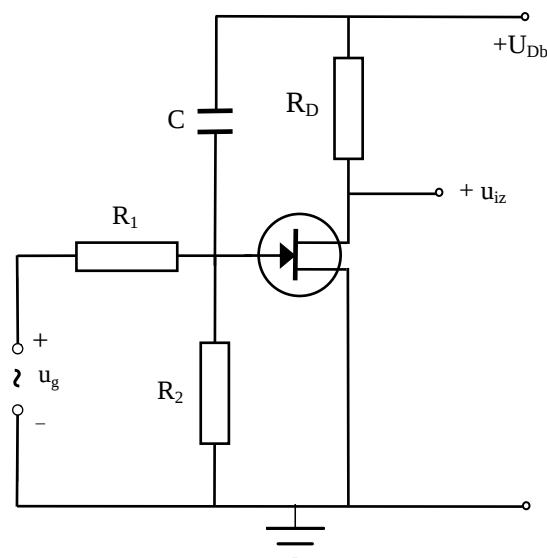
Rj. a) $A_v=-4.13$, b) $A_v=-3.03$, c) $C_S=215 \text{ nF}$

5. U pojačalu na slici n-kanalni spojni FET ima slijedeće karakteristike: $\mu = 200$ i $R_u = 40.5 \text{ k}\Omega$. Izračunajte naponsko pojačanje A_v u odnosu na ulazni napon i naponsko pojačanje A_{vg} u odnosu na napon generatora u_g . Koliko iznosi ulazni otpor sklopa? Koliko iznosi maksimalna struja kroz tranzistor za maksimalni napon generatora 3 V? $R_g = 5 \text{ k}\Omega$, $R_G = 1 \text{ M}\Omega$, $R_D = 5 \text{ k}\Omega$, $R_S = 250 \Omega$, $R_P = 7.5 \text{ k}\Omega$.



Rj. $A_v = -6.4$, $A_{vg} = -6.37$, $i_D = 6.4 \text{ mA}$

6. Za sklop s n-kanalnim spojnim FET tranzistorom prema shemi odredite pojačanje za signal frekvencije $f = 10 \text{ kHz}$. $R_D = 10 \text{ k}\Omega$, $R_1 = 10 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 20 \text{ k}\Omega$, $C = 10 \text{ pF}$, $R_u = 5 \text{ k}\Omega$, $\mu = 20$.



Rj. $A_v = -8.89$